

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号

特許第7128393号  
(P7128393)

(45)発行日 令和4年8月31日(2022. 8. 31)

(24)登録日 令和4年8月23日(2022. 8. 23)

(51)Int. Cl. F I  
H O I L 21/02 (2006. 01) H O I L 21/02 B

請求項の数 7 (全 23 頁)

<p>(21)出願番号 特願2020-155878(P2020-155878)                  (22)出願日 令和2年9月16日(2020. 9. 16)                  (65)公開番号 特開2022-49597(P2022-49597A)                  (43)公開日 令和4年3月29日(2022. 3. 29)                  審査請求日 令和4年3月14日(2022. 3. 14)</p> <p>早期審査対象出願</p>	<p>(73)特許権者 316001250                  株式会社プラウド                  滋賀県東近江市札の辻2丁目6番9号                  (72)発明者 八戸 啓                  滋賀県東近江市札の辻2丁目6番9号 株                  式会社プラウド内                  審査官 今井 聖和</p>
--	--

最終頁に続く

(54)【発明の名称】半導体結晶体の加工方法および半導体結晶体の加工装置

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

半導体結晶体を準備する工程と、  
 前記半導体結晶体を、導電性材料を主体とする1対の加圧治具で挟み込む工程と、  
 加熱装置により、前記1対の加圧治具および前記半導体結晶体を加熱し、前記半導体結晶体の温度を上昇させる工程と、

前記1対の加圧治具の間に電圧を印加し、一方の加圧治具と、前記半導体結晶体と、他方の加圧治具とを繋ぐ電流経路に電流を印加し、前記半導体結晶体を自己発熱させる工程と、

前記加熱装置による前記半導体結晶体への加熱と、前記半導体結晶体の自己発熱と、前記半導体結晶体と前記加圧治具との接触面の発熱と、によって、前記半導体結晶体の温度を塑性変形が可能な温度に維持したうえで、前記1対の加圧治具の間に圧力を加え、前記半導体結晶体を塑性変形させる工程と、を備えた、

半導体結晶体の加工方法。

【請求項2】

前記半導体結晶体を塑性変形させる工程において、前記一方の加圧治具と、前記半導体結晶体と、前記他方の加圧治具とを繋ぐ電流経路に流される電流が、電流制御された定値電流である、

請求項1に記載された半導体結晶体の加工方法。

【請求項3】